(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2008 年6 月12 日 (12.06.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/068979 A1

(51) 国際特許分類:
*H01L 33/00* (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/071026

(22) 国際出願日: 2007 年10 月29 日 (29.10.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2006-326720 2006 年12 月4 日 (04.12.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河崎仁彦 (KAWASAKI, Kimihiko) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 青木 陽太 (AOKI, Yota) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

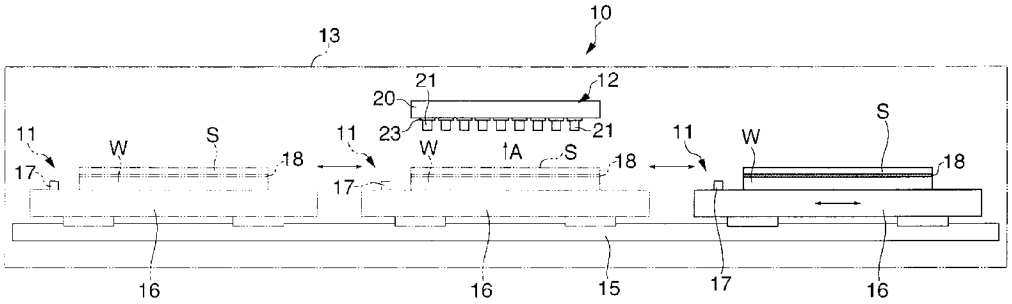
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(54) **Title:** ULTRAVIOLET IRRADIATION APPARATUS AND ULTRAVIOLET IRRADIATION METHOD

(54) 発明の名称: 紫外線照射装置及び紫外線照射方法




(57) **Abstract:** An object to be irradiated with ultraviolet is a semiconductor wafer (W) whereupon a protection sheet (S) is attached through an ultraviolet curing adhesive layer (18). An ultraviolet irradiation section (12), which has a plurality of ultraviolet light emitting diodes (21) on a substrate (20), is arranged at a position facing the wafer. The light emitting diodes (21) are arranged at substantially the same intervals along a direction that substantially orthogonally intersects with a relative shift direction to the wafer (W). While the light emitting diodes (21) on each low have substantially the same peak wavelength, the peak wavelengths of the adjacent light emitting diodes (21) are not necessarily the same.

(57) 要約: 紫外線硬化型接着剤層１８を介して保護シートＳが貼付された半導体ウエハＷを被照射体とし、これに相対する位置に複数の紫外線発光ダイオード２１を基板２０上に配置した紫外線照射部１２が設けられている。発光ダイオード２１は、ウエハＷとの相対移動方向に対して略直交する方向に沿って略等間隔を隔てて配置されているとともに、各列における発光ダイオード２１は、略同一のピーク波長を有する一方、隣り合う発光ダイオード２１のピーク波長は必ずしも同一でないように構成されている。

WO 2008/068979 A1